財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：林秀姿
電話：03-5916636
傳真：03-582-0466
E-mail：iris.lin@itri.org.tw

109000693626

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 109.04.27 文
檔號：109250

241403 三重區重新路五段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 109 年 04 月 24 日
發文字號：工研轉字第 1090006936 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：本院擬舉辦「雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案」之公開招標活動，請轉知貴會會員或貴局管理之科學園區內相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案(專利 41 案 57 件)之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、「讓與標的」共分為三個類別：（一）雷射技術(26 案 35 件)、（二）平面顯示器技術(10 案 17 件)及（三）半導體技術(5 案 5 件)。其中第 13 案為共有專利。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）109 年 5 月 22 日，開標日為 109 年 5 月 25 日。

（二）詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考下列網址：

工研院研發成果公告網站

（https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1071473646700714421）

（三）公開說明會資訊：

1. 舉辦時間：109 年 5 月 11 日下午 3 時至 4 時。

2. 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 52 館 624 室。

3. 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 5 月 7 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱、有興趣之標的技術類別）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 5 月 8 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

109 年度工研院
雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含雷射、平面顯示器與半導體技術相關專利 41 案 57 件之工研院應有部分 (以下簡稱「讓與標的」)。「讓與標的」共分為三個類別：（一）雷射技術(26 案 35 件)、(二)平面顯示器技術(10 案 17 件) 及(三)半導體技術(5 案 5 件)。

「讓與標的」中之案次 13 係與第三人共有(以下簡稱「共有標的」)。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）109 年 5 月 11 日 15 時整於工研院中興院區 52 館 624 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 5 月 7 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱、有興趣之標的技術類別。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 5 月 8 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 109 年 5 月 22 日 17 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件(如公司登記證明文件、商業登記證明文件、公司設立核准函、

公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「雷射、平面顯示器與半導體技術等相關專利讓與案投標」，於截標日 109 年 5 月 22 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、重要事項：

請投標人注意：「共有標的」係與第三人共有。故，「共有標的」之讓與，須經共有人同意後，始生效力。

七、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 109 年 5 月 25 日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。

4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」中之科專成果之讓與，經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准；而「共有標的」之讓與，須經共有人同意。此外，工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，應依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，取得主管機關核准及/或工研院同意後始得為之，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬

授權或讓與時亦同。

10.得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關核准及同意後始得為之：

（1）得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

（2）得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（3）得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區

域外製造或使用者；

（4）得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13.得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15.得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

17.得標廠商重整或聲請或被聲請重整;解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上(下稱：股權變動)時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於股權變動情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該股權變動情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解

除「讓與契約書」或以書面另議新約。

18.得標廠商應盡力進行產品開發工作，得標廠商未於合理期間內運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權他人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：讓與標的清單

技術類別	分類	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	公告號	歸屬	種類	專利起期	專利迄期	契約運用
(一)雷射技術(26案35件)	光路-設計	1	P08920109US	光偏振結合元件	獲證	美國	7,006,287	科專	發明	2006 0228	2024 0606	
		2	P27000019TW	離焦判定裝置及其判定方法	獲證	台灣	I451152	科專	發明	2014 0901	2031 1006	
		3	P27000043TW	光譜檢測裝置及光譜檢測方法	獲證	台灣	I456184	科專	發明	2014 1011	2031 1218	
		4	P27010058TW	物件表面之傾斜角的偵測方法、補償方法及其系統	獲證	台灣	I457541	科專	發明	2014 1021	2032 1223	
			P27010058US	物件表面之傾斜角的偵測方法、補償方法及其系統	獲證	美國	8,970,833	科專	發明	2015 0303	2033 0703	
		5	P27020030TW	多光點光路裝置	獲證	台灣	I491921	科專	發明	2015 0711	2033 1110	
		6	P27970109TW	雷射加工裝置	獲證	台灣	I404585	科專	發明	2013 0811	2028 1203	曾非專授權
		7	P27990062TW	改善景深之光學裝置與系統	獲證	台灣	I459066	科專	發明	2014 1101	2030 1117	曾非專授權
			P27990062US	改善景深之光學裝置與系統	獲證	美國	8,569,648	科專	發明	2013 1029	2031 0925	
		8	P27990112TW	應用於雷射加工之深度即時監控系統及其方法	獲證	台灣	I414385	科專	發明	2013 1111	2031 0804	
	光路-元件	9	P27000044TW	發光二極體元件、其導光結構的形成方法與形成設備	獲證	台灣	I447955	科專	發明	2014 0801	2031 1122	
			P27000044US	發光二極體元件、其導光結構的形成方法與形成設備	獲證	美國	8,823,032	科專	發明	2014 0902	2032 1224	
		10	P27990036TW	自動聚焦裝置及方法	獲證	台灣	I406025	科專	發明	2013 0821	2030 1124	
			P27990036CN	自動聚焦裝置及方法	獲證	中國	102478700	科專	發明	2014 0716	2031 0111	
			P27990036US	自動聚焦裝置及方法	獲證	美國	8,970,826	科專	發明	2015 0303	2033 1231	
	光路-校正	11	P08930109US	波長調變裝置	獲證	美國	7,460,568	科專	發明	2008 1202	2026 1213	
		12	P27960065US	一種雷射校正片及雷射校正系統	獲證	美國	7,847,239	科專	發明	2010 1207	2028 0401	
	製程-超短雷射加工	13	P27960104TW	利用飛秒雷射圖案化多晶氧化銦錫之方法	獲證	台灣	I424479	科專	發明	2014 0121	2028 0228	共有
			P27960104US	利用飛秒雷射圖案化多晶氧化銦錫之方法	獲證	美國	7,994,029	科專	發明	2011 0809	2030 0101	共有
		14	P27960105TW	以光學方法產生圖案化之極短紫外光源用於圖案加工之裝置及其方法	獲證	台灣	I388941	科專	發明	2013 0311	2028 0402	
		15	P27980056TW	光敏玻璃微結構之製造方法及用以製造該微結構之系統	獲證	台灣	I410380	科專	發明	2013 1001	2029 1110	
		16	P27980058TW	以飛秒雷射製作多晶矽圖案的方法和系統	獲證	台灣	I406106	科專	發明	2013 0821	2029 1112	
		17	P27990113TW	流體動壓軸封內靜止環或旋轉環之表面結構及其製造裝置與製造方法	獲證	台灣	I435990	科專	發明	2014 0501	2031 0512	
	製程-圖案加工	18	P27000020TW	雷射切割方法與裝置	獲證	台灣	I476063	科專	發明	2015 0311	2031 1003	
			P27000020CN	激光切割方法與裝置	獲證	中國	103030266	科專	發明	2015 0415	2031 1024	
		19	P27010021TW	雙極板製造方法	獲證	台灣	I464952	科專	發明	2014 1211	2032 1002	曾非專授權
		20	P27010060TW	導電膜及其製法	獲證	台灣	I514424	科專	發明	2015 1221	2032 1127	
		21	P27020022TW	導電線路的形成方法	獲證	台灣	I481327	科專	發明	2015 0411	2033 1030	
	製程-雷射修補	22	P27990029TW	平面顯示器之修補方法與系統	獲證	台灣	I437338	科專	發明	2014 0511	2030 1014	
			P27990029CN	平面顯示器的修補方法與系統	獲證	中國	102466900	科專	發明	2015 0218	2030 1103	
		23	P27990063TW	平面顯示模組之修補方法與系統	獲證	台灣	I465791	科專	發明	2014 1221	2030 1130	

技術類別	分類	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	公告號	歸屬	種類	專利起期	專利迄期	契約運用
(一)雷射技術(26案35件)	雷射源	24	P27000062TW	雷射控制裝置	獲證	台灣	I454006	科專	發明	2014 0921	2031 1117	
		25	P27990019TW	環形迴路光學系統及全光纖式 Q-開關雷射	獲證	台灣	I448024	科專	發明	2014 0801	2030 0919	
		26	P27990061TW	用於寬頻雷射之偏振調變裝置及其雷射系統	獲證	台灣	I420170	科專	發明	2013 1221	2030 1213	曾非專授權
			P27990061US	用於寬頻雷射之偏振調變裝置及其雷射系統	獲證	美國	8,855,152	科專	發明	2014 1007	2033 0318	
(二)平面顯示器技術(10案17件)	R2R傳輸	27	P27970061TW	吸附式滾輪及其輸送裝置	獲證	台灣	I349644	科專	發明	2011 1001	2028 0917	
			P27970061CN	吸附式滾輪及其輸送裝置	獲證	中國	101683936	科專	發明	2011 0105	2028 0923	
			P27970061JP	吸附式滾輪及其輸送裝置	獲證	日本	4829947	科專	發明	2011 0922	2028 0929	
			P27970061US	吸附式滾輪及其輸送裝置	獲證	美國	7,654,427	科專	發明	2010 0202	2028 1109	曾非專授權
		28	P27970062TW	軟板輸送導正裝置與方法	獲證	台灣	I367855	科專	發明	2012 0711	2028 0923	曾非專授權
			P27970062CN	軟板輸送導正裝置與方法	獲證	中國	101683935	科專	發明	2011 0316	2028 0925	
		29	P27980037TW	對位裝置與對位方法	獲證	台灣	I418959	科專	發明	2013 1211	2029 1026	曾非專授權
		30	P27980059TW	料帶捲轉動機構及其料帶捲導正裝置	獲證	台灣	I379805	科專	發明	2012 1221	2029 1203	曾非專授權
			P27980059CN	料帶捲轉動機構及其料帶捲導正裝置	獲證	中國	102101599	科專	發明	2013 0821	2029 1216	
		31	P27980085TW	用於軟性基材之連續滾壓式夾持裝置	獲證	台灣	I386356	科專	發明	2013 0221	2029 1209	曾非專授權
			P27980085CN	用於軟性基材的連續滾壓式夾持裝置	獲證	中國	102107549	科專	發明	2014 0226	2029 1222	
	鍍膜技術	32	P27980061TW	承載裝置與處理基板的方法	獲證	台灣	I409909	科專	發明	2013 0921	2029 1214	
		33	P27990022TW	具有氧化鋅薄膜之半導體元件	獲證	台灣	I440175	科專	發明	2014 0601	2030 1101	
		34	P27990058TW	薄膜圖案的沉積裝置與方法	獲證	台灣	I427839	科專	發明	2014 0221	2030 1202	
			P27990058CN	薄膜圖案的沉積裝置與方法	獲證	中國	102485937	科專	發明	2014 0528	2030 1220	
	光路技術	35	P27960066TW	高效能雷射輔助轉印系統及轉印元件	獲證	台灣	I375498	科專	發明	2012 1021	2027 1120	
	基板結構	36	P27010046TW	基板結構及其製法	獲證	台灣	I478299	科專	發明	2015 0321	2032 1224	
(三)半導體技術(5案5件)	晶圓盒	37	044890039US	晶圓載入機	獲證	美國	6,997,664	科專	發明	2006 0214	2024 0113	
		38	044890063US	前開式晶圓盒自動載入裝置	獲證	美國	6,896,470	科專	發明	2005 0524	2023 0115	
		39	044900048US	潔淨容器之氣孔裝置	獲證	美國	6,732,877	科專	發明	2004 0511	2022 0429	曾非專授權
		40	044900049US	晶圓保持件(Wafer Retainer)	獲證	美國	6,591,987	科專	發明	2003 0715	2022 0219	曾非專授權
		41	044910037US	晶圓盒門體之閂鎖機構	獲證	美國	6,902,063	科專	發明	2005 0607	2023 0724	曾非專授權

【備註】: 本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定 國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利